

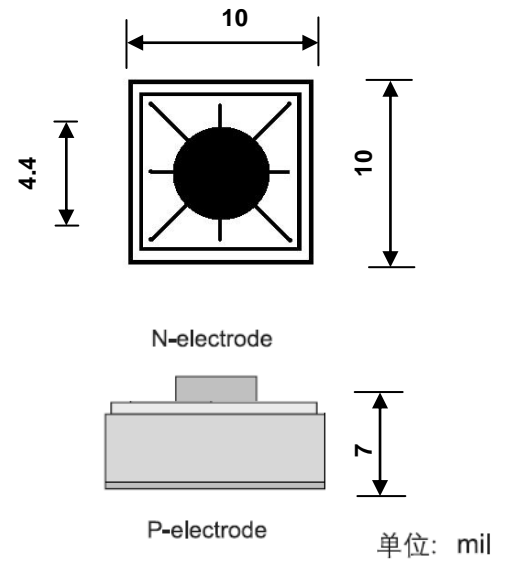


◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好一致性

◆ 物理参数:

P 电极	金
N 电极	金
芯片尺寸	10mil × 10mil (250 ± 25μm × 250 ± 25μm)
芯片厚度	7mil (175 ± 25μm)
焊盘尺寸	4.4mil (110 ± 10μm) in diameter



◆ 光电参数: (Tc=22°C, I_F=20mA)

产品型号	波长范围 (λ _D , nm)		工作电压 (V _F , V)		反向漏电流 (I _R , μA) @V _R =10V	半波宽度 (Δλ, nm)
	Min	Max	Min	Max		
S-10R3MUX-610J**U	610	620	1.9	2.4	<0.5	<20
S-10R1MUX-620G**U	620	627				
S-10R2MUX-625G**U	625	632				
S-10R3MUX-630J**U	630	640				

◆ 光强等级: (Tc=22°C, I_F=20mA)

等级	...	K	L	M	N	O	...
Iv scale (mcd)	...	240~300	300~360	360~420	420~500	500~600	...

◆ 其它说明:

- 光电参数均系三安光电测试仪器在晶圆条件下的测试参数, 98%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于 280°C, 持续时间小于 10 秒
- AlGaInP LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 ±1.0nm
- 可根据客户需要订做特殊规格的芯片